

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第4区分

【発行日】平成25年2月21日(2013.2.21)

【公開番号】特開2012-48779(P2012-48779A)

【公開日】平成24年3月8日(2012.3.8)

【年通号数】公開・登録公報2012-010

【出願番号】特願2010-189132(P2010-189132)

【国際特許分類】

G 11 C 13/00 (2006.01)

H 01 L 27/105 (2006.01)

H 01 L 45/00 (2006.01)

H 01 L 49/02 (2006.01)

【F I】

G 11 C 13/00 A

H 01 L 27/10 4 4 8

H 01 L 45/00 Z

H 01 L 49/02

【手続補正書】

【提出日】平成24年12月28日(2012.12.28)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0009

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0009】

請求項3記載の発明は、請求項1又は2記載の発明と同様の構成を備えると共に、前記高抵抗状態から前記低抵抗状態へ移行させる場合の前記抵抗体の抵抗値は3Mから0.  
3Mであることを特徴とする。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0013

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0013】

請求項7記載の発明は、請求項4から6のいずれか一項に記載の発明と同様の構成を備えると共に、前記高抵抗状態から前記低抵抗状態へ移行させる場合の前記抵抗体の抵抗値は3Mから0.3Mであることを特徴とする。

【手続補正3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

前記高抵抗状態から前記低抵抗状態へ移行させる場合の前記抵抗体の抵抗値は3Mから0.3Mであることを特徴とする請求項1又は2記載のメモリ素子の駆動方法。

【手続補正4】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 7】

前記高抵抗状態から前記低抵抗状態へ移行させる場合の前記抵抗体の抵抗値は3Mから0 . 3Mであることを特徴とする請求項4から6のいずれか一項に記載のメモリ素子を用いた記憶装置。